

SH79F082 应用指南

1 概述

SH79F082 是一颗采用单机器周期增强型 8051 内核的单片机，内部采用 FLASH 存储程序代码，可以多次烧写或者擦除，方便用户调试和在线更新。

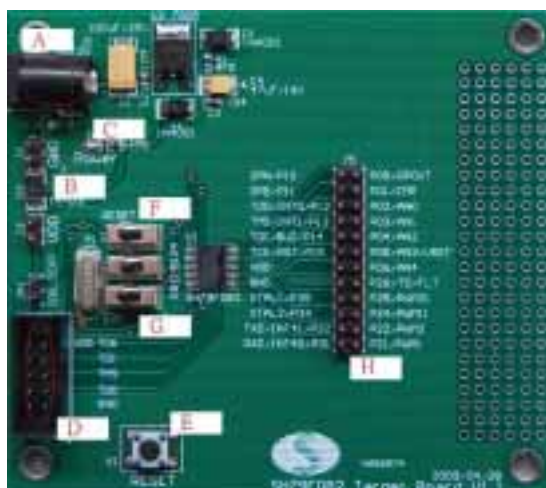
中颖 SH79F082 系列单片机的在线仿真和下载烧录可以通过 JET51 仿真器实现。该工具基于 Keil μ vision 集成开发环境，通过 JTAG 方式和单片机连接，实现全功能在线仿真和下载烧录功能。

1.1 封装

SH79F082 提供 TSSOP24 封装。

1.2 演示板 (Target Board)

SH79F082 提供了一套演示板，供客户熟悉芯片功能。如下图：



SH79F082 演示板 (TSSOP24)



板中各部分功能说明：

A. 外部供电接口 1 (内正外负)

外接 9~12V 电源，经过板上稳压电路产生 5V 电压作为芯片的供电电源使用。采用外部供电接口 1 供电，演示板供电电源为 5V，不可调。

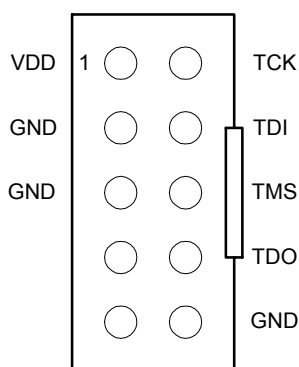
B. 外部供电接口 2

外部供电电源接口，分别与芯片的 VDD 和 GND 管脚连接。采用外部供电接口 2 供电，演示板供电电源可调。但注意供电电源不要超过芯片最高工作电压。

C. 电源指示灯

D. JTAG 仿真接口

JTAG 仿真接口和 JET51 仿真器一一对应，可用 10 芯扁平线直接连接。仿真时，演示板的供电电源可通过仿真接口的 VDD 管脚直接获得。



E. 复位按键

F. RESET 引脚拨位开关

板上可以选择 P1.5 用作 I/O 还是复位管脚 (通过下载时选择的 “Option” 来定)。若选择作为 I/O 使用，则将拨位开关拨到 IO 标识一侧 (即靠近芯片一侧)。若选择作为复位管脚使用，则将拨位开关拨到 RESET 标识一侧 (即靠近振荡器插座一侧)。

G. 振荡器引脚拨位开关

板上可以选择内部 RC 或外部晶体(16MHz)振荡器(通过下载时选择的 “Option” 来定)。若选择内部 RC，则 P3.4/P3.5 可用作 I/O 口，此时可将拨位开关拨到 IO 标识一侧 (即靠近芯片一侧)。若选择外部晶体(16MHz)振荡器，则将拨位开关拨到另外一侧 (即靠近振荡器插座一侧)。

H. 芯片的全部输入输出口或其它共享的功能口

此演示板和 JET51 配合使用，即可仿真 SH79F082 的全部功能。演示板的供电可以由外部供电接口 1 或外部供电接口 2 或仿真接口提供，不管使用哪一种供电方式，最终外部供电接口 1 处的电压为芯片的供电电压。



2 仿真

2.1 仿真软件的安装

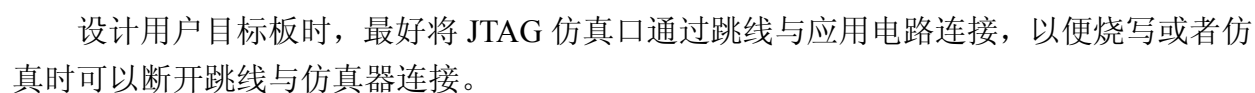
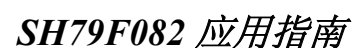
安装步骤:

- 1) 安装 Keil μ vision2 (V2.34 及以上版本) 或者 μ vision3。
- 2) 安装中颖 SH79F 组件库 JET51_Keil_Vxxx.exe (其中 Vxxx 表示版本号) 到 Keil c 的安装目录下 (例如: c:\keil\)。
- 3) 将 JET51 仿真器通过 USB 连接计算机, 此时红色电源灯和绿色 USB 灯会同时亮起, 说明安装成功。

2.2 硬件的安装

安装步骤:

- 1) 将 SH79F082 用户目标板上的 JTAG 仿真口 (VDD, TCK, TDI, TMS, TDO, GND) 与 JET51 仿真器的 JTAG 仿真口通过扁平电缆相连即可。
- 2) 如果需要仿真, 当使用晶振时, 需要把振荡器引脚拨位开关拨到左侧; 使用内部 RC 时, 则把振荡器引脚拨位开关拨到右侧, 振荡器输入输出引脚作为 IO 使用。
- 3) 当使用 JET51 仿真、下载时, JTAG 仿真口不能够用做 I/O, 另外为确保正常通讯, 最好将 TCK, TDI, TMS, TDO 与用户目标板上的外接线路断开, 如果不断开, 必须保证 TCK, TDI, TMS, TDO 负载电容不能超过 103 (10000pF), 否则通讯可能会失败。
- 4) 用户目标板电源上的负载电容不得超过 220 μ F, 否则可能导致通讯失败。

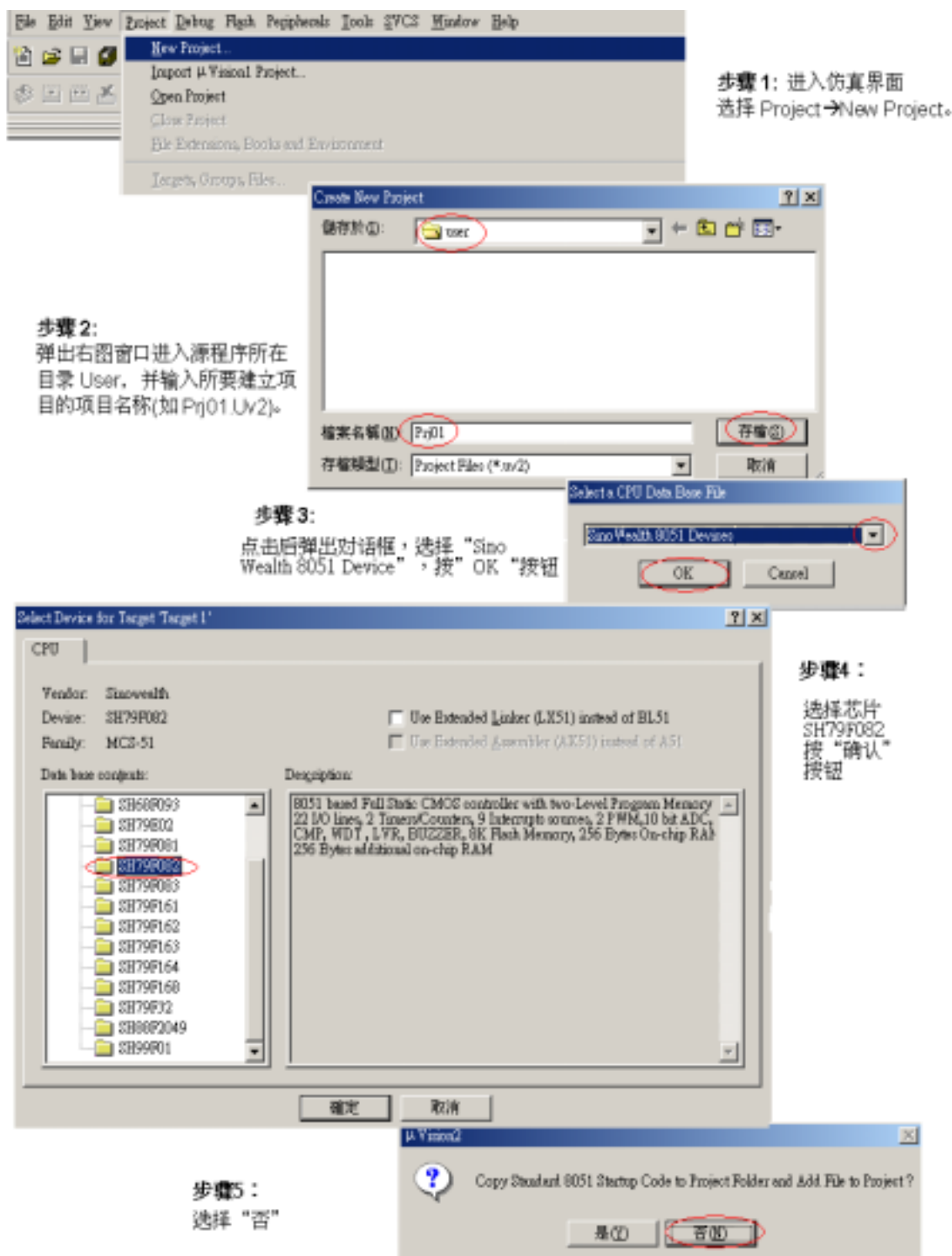




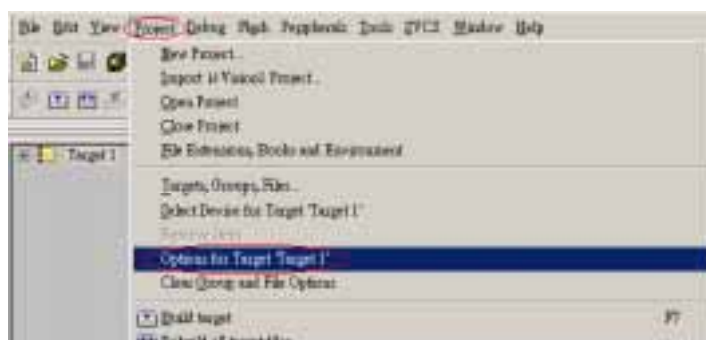
2.1.1 新建一个 Project

示例: 用户的源程序在目录 User 下, 文件名为 aa.asm。

现在需要对此建立一个新的 Project, 操作如下:

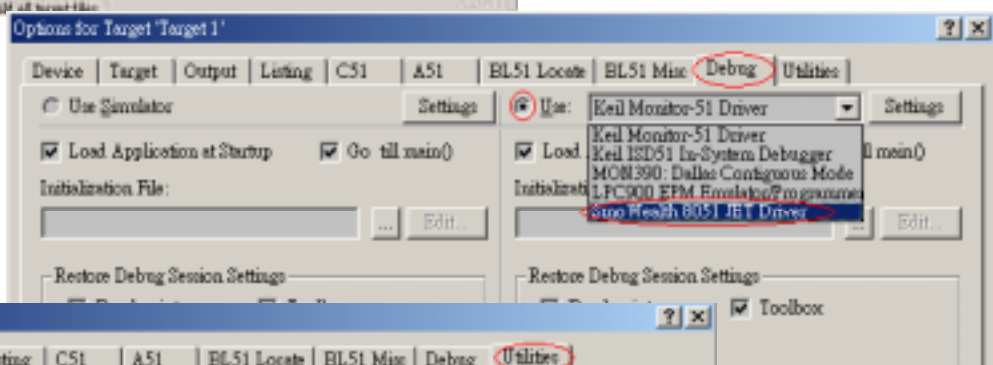


至此, 已完成建立一个空的项目。下面设置项目属性。

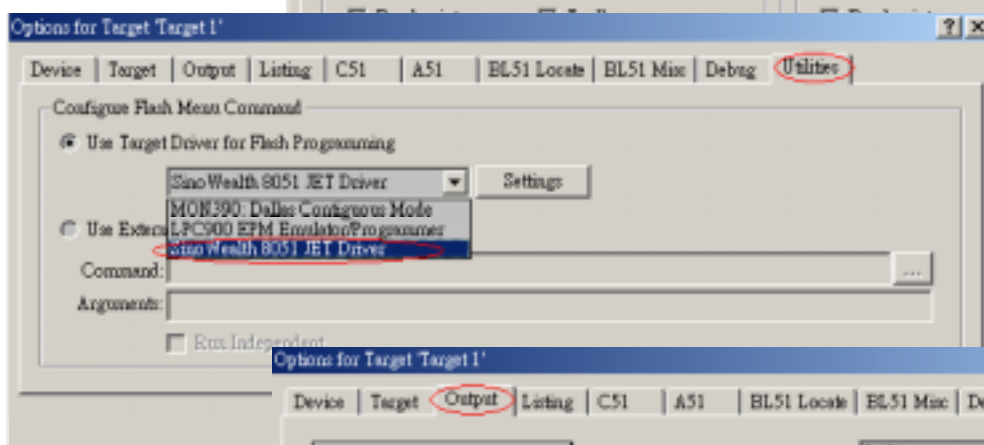


步骤 6:
选择 Project
→Options for Target 'Target1'。

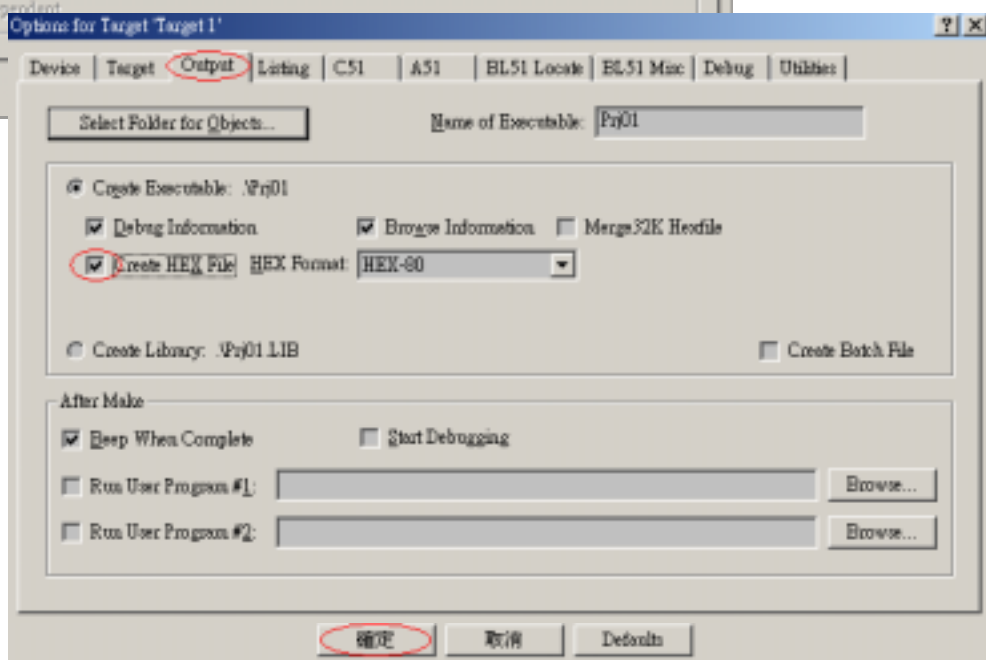
步骤 7:
选择 Debug→Use
→Sino Wealth 8051
JET Driver。



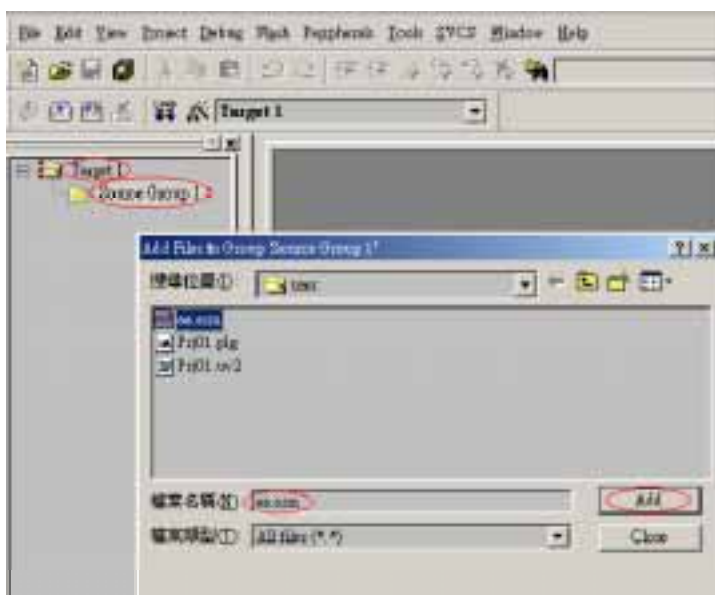
步骤 8:
选择 Utilities
→Sino Wealth 8051
JET Driver
→确认。



步骤 9:
选择 Output
→选择“Create HEX
File”→确认。



至此，项目属性设置完毕。下面将已经编写好的程序添加到项目中。



步骤 10:

双击 Target1

→选择“Source Group1”，按右键

→选择目标目录，例如“User”

→选择目标文件，例如“aa.asm”

→点击“Add”按钮。

步骤 11:

关闭 Step10 中“Add Files to Group ‘Source Group1’”窗口

→双击“Source Group1”

→双击“aa.asm”。

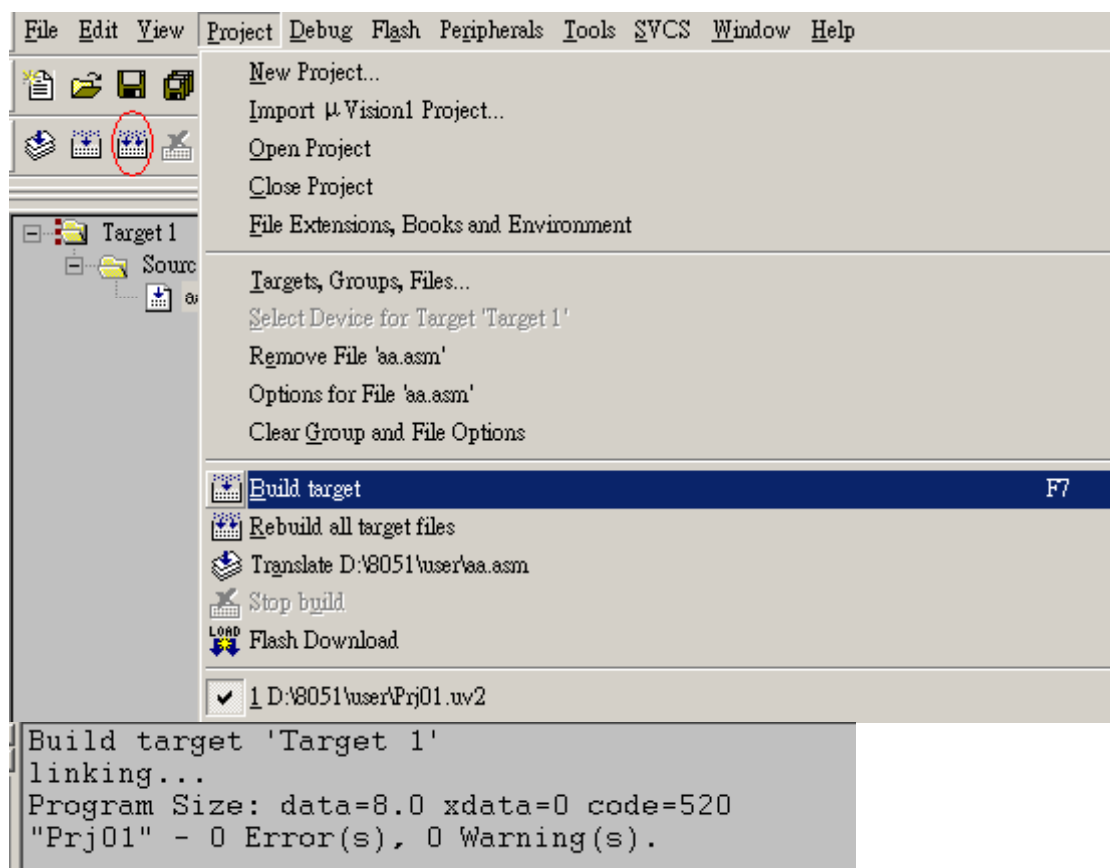




2.1.2 程序的编译和下载

2.2.4.1 程序的编译

当程序编写完成后，点击菜单 Project\Build target(或编译按钮)，完成编译，生成.OBJ 文件和.HEX 文件。当存在编译错误(Error)，则不会生成.OBJ 文件和.HEX 文件。

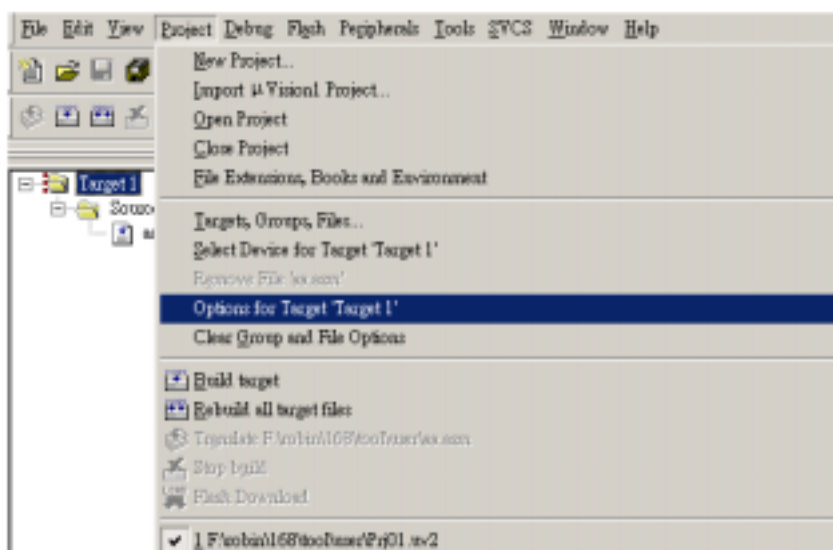




2.2.4.2 程序的下载

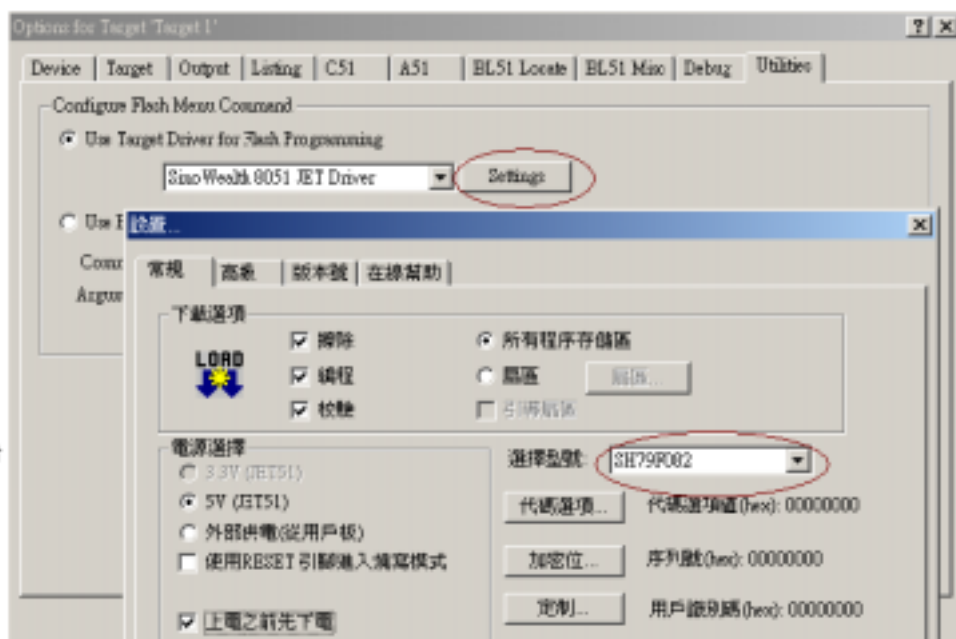
2.2.4.2.1 下载前的选项设置

程序下载前的选项设置包括选用芯片设置，上电方式设置，CODE OPTION 设置等。所有设置系统会自动保存。之后再行程序下载时，可以跳过此步骤。



步骤 1:
点击 Project
→ Option for Target 'Target 1'
(或直接点击快捷按钮)。

步骤 2:
弹出右图窗口后点击
Utilities
→ Setting
→ 选择
“SH79F082”





步骤3：

用户根据需
要选择上电
方式及option
等选项，
全部选择完
成后点击“
确定”按钮

步骤4：

按“确定”按钮完成设置。





注意 JET51 仿真器提供了 2 种不同的上电方式，在步骤 3 中设置。

1) 方式 1: JET51 仿真器供电

选择“5V(JET51)”和“Power Off, Power On again”。其中，“Power Off, Power On again”是指“下电/上电后重进 JTAG 模式”，通常在仿真或者下载出错时选用此方式。

在程序下载和仿真的时候，用户目标板的供电由 JET51 仿真器提供。此时，用户目标板不需要外接任何电源，电源会通过 JET51 仿真器电源直接供给用户目标板。

如若用户目标板耗电小于 20mA，推荐用方式 1。

2) 方式 2: 外部供电

选择“External(Target board)”。

在程序下载和仿真的时候，用户目标板通过外接电源供电。此时，上电顺序有严格要求。

步骤 1：确认用户目标板处于断电状态。

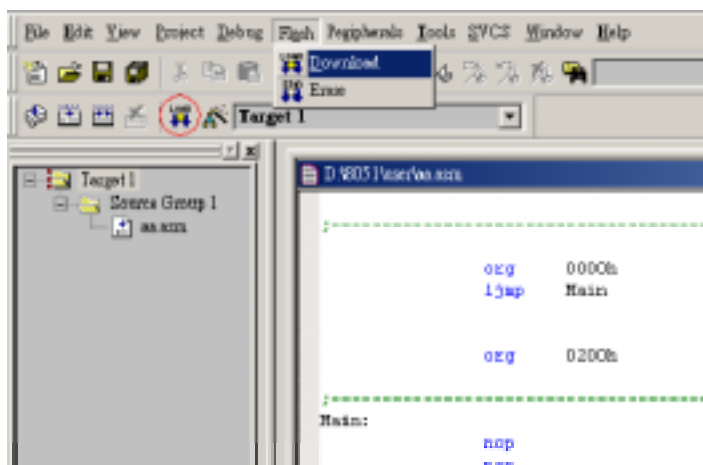
步骤 2：连接 JET51 仿真器和用户目标板。

步骤 3：JET51 仿真器和 PC 通过 USB 连接，红色电源灯和绿色 USB 灯全部点亮。

步骤 4：用户目标板接入外部电源。

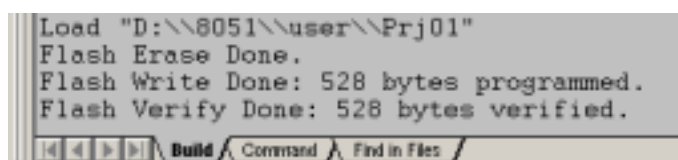
此后调试可以反复下载和仿真，无须下电及重新连接。

2.2.4.2.2 程序下载



按“Download”快捷按钮
或点击 Flash→Download。

Download成功。

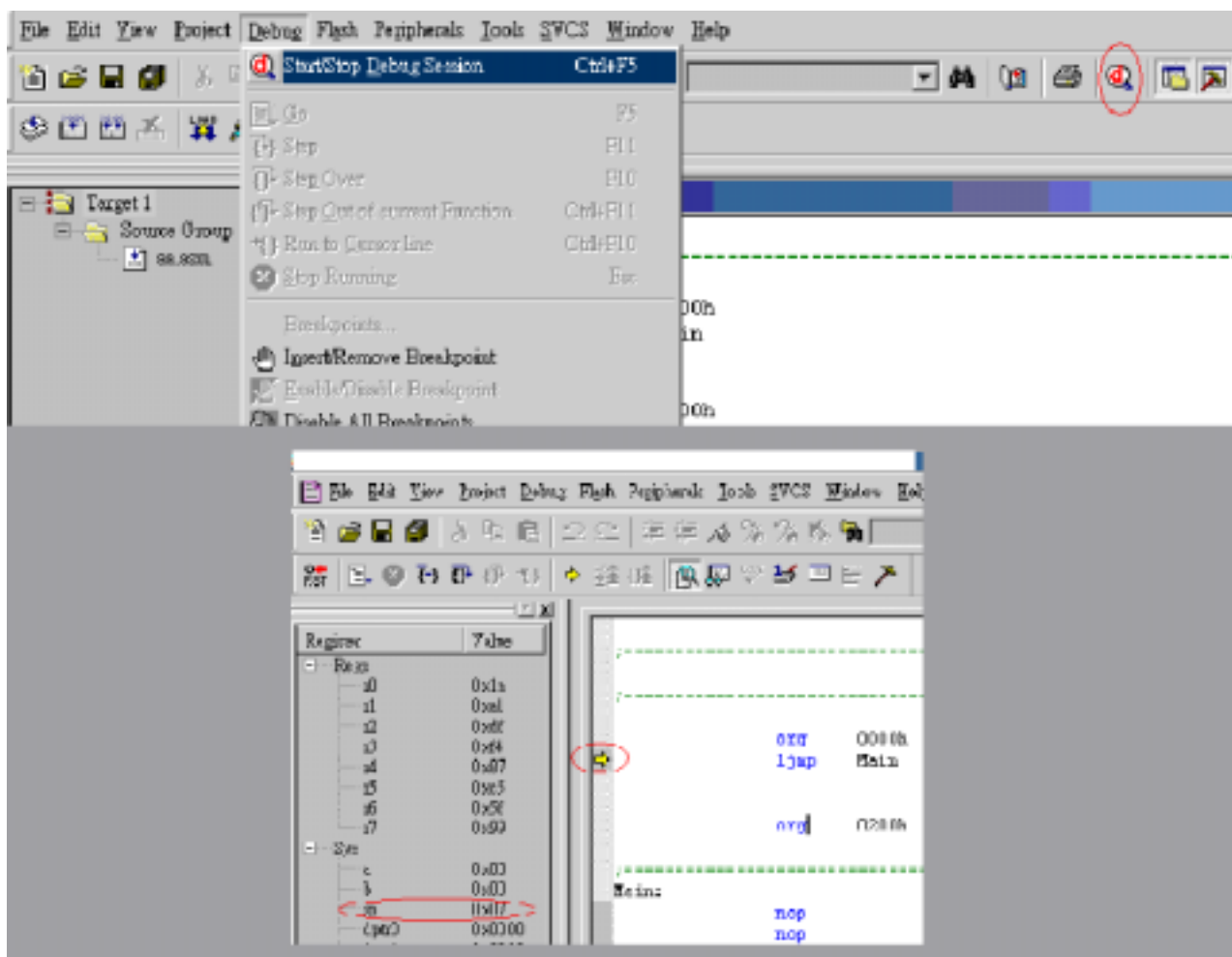




2.1.3 程序仿真

当程序已经下载到芯片中，点击菜单 Debug\Start/Stop Debug Session 或快捷按钮进入程序仿真模式。

当 JTAG 完全连接上以后，会有黄色箭头指向 0000H 处，同时左边寄存器窗口 SP 的值为 07H，表示成功进入调试模式可以进行仿真了。用户可以通过选择 Debug 菜单下的命令来执行 Step、Step Over、Run、Stop 等操作，也可以执行增加断点、减少断点的操作。



注意：

- 1) 断点为将该指令执行完以后，再停止。
- 2) 执行 Step Over 指令，在执行到 ACALL、LCALL 等语句时，会将 ACALL、LCALL 下一条语句执行完才停止。
- 3) 仿真器只支持 7 个断点。若超过 7 个断点，则只支持最后设置的 7 个断点。以前的断点将被忽略。
- 4) 程序仿真无误后，断开外加电源，拔掉 JTAG 连线。
- 5) 用户目标板接入外部电源，开始独立运行（脱机模式）。



3 应用注意事项

3.1 和传统 8051 差异

SH79F082 是一颗采用增强型 8051 内核的单片机，功能比传统型 51 内核有以下增强：

3.1.1 SH79F082 机器周期为 1 个振荡器周期，而传统型 51 核机器周期为 12 个振荡器周期。其指令执行效率约为同频率的传统 8051 的 10 倍。详细指令执行时间参见 SPEC。

3.1.2 SH79F082 系统时钟可以 1,2,4,12 分频,上电后默认为 12 分频。

3.1.3 SH79F082 提供增强型的乘/除法指令,支持 $16\text{BIT} \times 8\text{BIT}$ 和 $16\text{BIT} \div 8\text{BIT}$ 运算。

3.1.4 SH79F082 提供双 DPTR 指针，用户在使用查表，数据搬移等操作时会更方便。

3.1.5 SH79F082 复位脚采用低电平复位，不同于传统 8051 的高电平复位。

其它功能上的差异请参见 SPEC。

3.2 FLASH ROM

3.2.1 SH79F082 每 1K BYTE 为 1 个扇区 (SECTOR)，除了最后一个扇区因为存放有 OPTION 信息被硬件设定为不能做扇区擦除(SECTOR ERASE)外，其它每个扇区可分别进行擦除。全局擦除(MASS ERASE)可以擦除所有扇区。

3.2.2 SH79F082 可以对 flash 进行加密，加密以 2K 为一个单位。

3.2.3 最后一个扇区的最后 64BYTE (SH79F082 ROM 地址的 1FC0H~1FFFH) 保留，不可以用作程序 ROM (硬件屏蔽)。

3.2.4 存放在 FLASH ROM 中的程序可以对不在同一扇区的 FLASH ROM 编程 (SSP 模式)，因此可以当作 EEPROM 来使用。扇区中的数据从 0 改为 1 时，可以直接烧写。但从 1 改为 0 时，必需通过扇区擦除后才能实现。

3.2.5 在进行 FLASH 编程时，系统时钟不能低于 1M。

3.2.6 SH79F082 支持 ICP 功能，即在客户应用电路板完成后，在客户电路板上通过烧写器烧写程序代码。但须注意，P1.2~P1.5 四个烧写口不能有大于 10nF 的电容性负载，VDD 管脚上的负载电容不得超过 220μF，否则可能导致烧写失败。

3.2.7 FLASH 烧写/擦除步骤。

3.2.7.1 烧写

- 1) 关闭中断。在整个烧写期间无法响应中断，但中断申请标志位照常会置 1。因此如果烧写期间来了中断，烧写完成后，打开中断允许位，中断服务程序仍将执行。
- 2) 设置 XPAGE, IB_OFFSET 寄存器。此 2 个寄存器对应烧写地址。其中 IB_OFFSET 对应地址低位，XPAGE 对应地址高位。
- 3) 将准备填充值写入 IB_DATA。此寄存器中的值将被写入到 FLASH 中指定地址。
- 4) 按照顺序设置 IB_CON1~5。其中数值如下所列。

IB_CON1----→ #6EH ;表示烧写。



IB_CON2 ---→ #05H
IB_CON3----→ #0AH
IB_CON4 ----→ #09H
IB_CON5 ----→ #06H

注意顺序不能有错，数值也必须正确。烧写完成后这 5 个寄存器硬件自动清零，防止误写。因此下次写操作必须重新填充这 5 个寄存器。

- 5) 软件写入 IB_CON5 后启动硬件写操作，CPU 将进入 IDLE 模式。烧写完成后自动唤醒。此步骤由 CPU 自动完成，用户无须干预。
- 6) 软件设置完上述寄存器后插入 4 个 NOP 指令，保证烧写完成后 CPU 从 IDLE 模式可靠唤醒。
- 7) 如需继续写入数据，跳转至第 3 步。
- 8) 将 XPAGE 寄存器清除为零，恢复中断设置。
- 9) 程序示例：注意示例中各数据均为示意性数据，应用时请根据具体情况设置。

```
PUSH    IEN0
CLR     EA                      ;步骤 1
MOV     XPAGE,#18H             ;步骤 2
MOV     IB_OFFSET,#00H
MOV     IB_DATA,#05H           ;步骤 3
MOV     IB_CON1,#6EH           ;步骤 4
MOV     IB_CON2,#05H
MOV     IB_CON3,#0AH
MOV     IB_CON4,#09H
MOV     IB_CON5,#06H
; /*步骤 5: CPU 进行烧写，自动进入 IDLE 模式，完成后自动唤醒*/
NOP                      ;步骤 6
NOP
NOP
NOP
; /*步骤 7: 如果需要继续写入数据，重复上述步骤*/
MOV     XPAGE,#00H           ;步骤 8
POP     IEN0
```

3.2.7.2 擦除：

- 1) 关闭中断。在整个烧写期间无法响应中断，但中断申请标志位照常会置 1，因此如果擦除期间来了中断，擦除完成后，打开中断允许位，中断服务程序仍将执行。
- 2) 根据需要擦除的扇区设置 XPAGE。1K BYTE 为一个扇区，SH79F082 ROM 为 8K



BYTE, XPAGE BIT7~2 对应扇区号, XPAGE BIT1~0 对应被擦除扇区高两位, IB_OFFSET 寄存器无效。

- 3) 按照顺序设置 IB_CON1~5, 其中数值如下所列。

IB_CON1----→ #0E6H ;表示擦除

IB_CON2 ---→ #05H

IB_CON3----→ #0AH

IB_CON4 ----→ #09H

IB_CON5 ----→ #06H

注意顺序不能有错, 数值也必须正确。擦除完成后, 这 5 个寄存器硬件自动清零, 防止误擦除。因此下次擦除操作必须重新填充这 5 个寄存器。

- 4) 软件写入 IB_CON5 后启动硬件擦除操作, CPU 将进入 IDLE 模式。擦除完成后自动唤醒。此步骤由 CPU 自动完成, 用户无须干预。
- 5) 软件设置完上述寄存器后插入 4 个 NOP 指令, 保证擦除完成后 CPU 从 IDLE 模式可靠唤醒。
- 6) 如果需要继续擦除扇区, 跳转至第 3 步。
- 7) 将 XPAGE 寄存器清除为零, 恢复中断设置。
- 8) 程序示例: 注意示例中各数据均为示意性数据, 应用时请根据具体情况设置。

```
PUSH    IEN0
CLR      EA                      ;步骤 1
MOV      XPAGE,#18H             ;步骤 2
MOV      IB_OFFSET,#00H
MOV      IB_DATA,#05H           ;步骤 3
MOV      IB_CON1,#0E6H          ;步骤 4
MOV      IB_CON2,#05H
MOV      IB_CON3,#0AH
MOV      IB_CON4,#09H
MOV      IB_CON5,#06H
; /*步骤 5: CPU 进行烧写, 自动进入 IDLE 模式, 完成后自动唤醒*/
NOP                      ;步骤 6
NOP
NOP
NOP
; /*步骤 7: 如果需要继续写入数据, 重复上述步骤*/
MOV      XPAGE,#00H           ;步骤 8
POP      IEN0
```



3.3 RAM

3.3.1 SH79F082 有 256 BYTE 内部 RAM, 256BYTE 外部 RAM。

3.3.2 内部 RAM 地址范围为 0~FFH, 其中 0~7FH 既可以直接寻址, 也可以间接寻址, 80~FFH 只能用间接寻址。若用直接寻址访问此地址范围, 访问到的是系统寄存器。

3.3.3 外部 RAM 地址范围为 0~FFH。传统的 8051 用 MOVX A, @Ri (i=0 或 1) 能访问 0~FFH 地址范围内的外部 RAM。

3.4 中断

3.4.1 OVL 复位:

SH79F082 为进一步增强 CPU 运行可靠性, 内建程序超范围溢出检测电路, 一旦检测到程序计数器的值超出 ROM 最大值, 或者发现指令操作码(不检测操作数)为 8051 指令集中不存在的 A5H, 便认为程序跑飞, 产生 CPU 复位信号, 同时将 WDOF 标志位置 1。为应用这个特性, 用户应该将未使用的 Flash ROM 用 0xA5 填满。

附: 在程序中用 A5H 填充未用到 ROM 地址的方法:

首先定义宏:

```
Fill_A5H    MACRO    N
REPT        N
DB          A5H
ENDM
ENDM
```

然后在没有用到的 ROM 空间调用宏, 比如 1000H 到 11FFH 没有用到, 可以用如下方法填充:

```
CSEG AT     1000H
Fill_A5H    512
```

3.4.2 PORT 口外部中断

- 1) 由于 I/O 复用功能比较多, 只有当相应的 PORT 口设置为 I/O 功能而且设置为输入状态, 才有可能产生外部中断。内部上拉功能也需要软件控制。注意, 内部上拉电阻大概在 30KΩ 左右, 如果刚开始 PORT 口输出低电平, 中断初始化程序中将 PORT 口设为输入并且将内部上拉功能打开, 然后马上开启 PORT 口中断控制位, 而且设置为上升沿触发, 由于引脚上有电容负载, 内部上拉比较慢, 内部中断上升沿检测电路可能会检测到此上升信号, 产生一次中断请求。因此, 建议此情况下, 内部上拉打开后, 等待一段时间 (比如 5 个 NOP 指令) 后, 清除中断标志位, 再打开中断允许控制位。
- 2) 所有 PORT 口中断, 如果设为电平触发, 则 FLAG 标志位仅仅受外部 PORT 口电平控制, 电平为低, 则 FLAG 为 1, 电平为高, 则 FLAG 自动变为 0 (和传统 8051 兼容)。但是要注意外部中断 4 有多个中断源, 需要在中断服务程序中查询标志位来确认是哪



一个中断源触发中断，如果外部中断低电平持续时间很短，小于中断响应时间，则中断服务程序中会查不到中断标志位，因此外部中断 4 设置为电平触发时，需要保证低电平持续时间大于中断响应时间（微秒级）。设为边沿触发时无此问题。如果设置外部中断 4 电平触发模式来唤醒 POWER DOWN 模式，由于进入 POWER DOWN 模式后，唤醒需要 2ms 的 WARM UP 时间，因此如果外部中断 4 低电平持续时间小于 2ms，中断服务程序中会检测不到中断标志位，无法区分是哪一个中断源唤醒。

3.5 IDLE & POWER DOWN 模式

程序编写时注意 IDLE 或 POWER DOWN 指令之后务必加至少 3 条 NOP 指令，以保证系统能够稳定进入 IDLE 或者 POWER DOWN 模式。

```
.....  
MOV    SUSLO,  #55H  
ORL     PCON,  #01H;idle mode (or #02H: power-down mode)  
NOP                               ;必须添加  
NOP                               ;必须添加  
NOP                               ;必须添加  
.....                           ;后续程序。调试程序时如果需要在 Idle 唤醒处设置断点，  
                                       ;断点位置要放在 3 个 NOP 之后。
```

3.6 PWM

3.6.1 SH79F082 中有 2 路独立的 PWM，每路 PWM 提供两路输出，输出波形可以选择中心对齐和边沿对齐模式。每路输出有单独的允许位，以及单独的高低电平控制位。

3.6.2 PWM 有 3 个中断源，分别为周期溢出中断（因为周期寄存器共享,因此只有一个周期中断），占空比溢出中断（2 路 PWM 输出各占一个中断）。他们共享一个中断入口地址，有各自的使能位。

3.6.3 PWM 模块具有 12BIT 周期以及 12BIT 占空比寄存器（各自的占空比分别可调）和 12BIT 死区控制寄存器，设置寄存器时，需要按照先写低位，后写高位的顺序。如果只写低位，内部寄存器值不会更新。

3.6.4 PWM 有效期间所有寄存器均可任意修改。修改后的内容会在下一个 PWM 周期生效，但 PWM 输出控制寄存器是修改后立即生效。

3.6.5 设置 PWM 寄存器前需要先将 PWMLO（\$E7）寄存器值设为 55H，否则硬件拒绝修改寄存器。

3.6.6 PWM 模块具有故障检测功能，当检测到有效故障信号后,则 PWM 输出会立即变为无效电平。



3.7 ADC

- 3.7.1** SH79F082 内部集成 10BIT 分辨率 ADC, ADC 时钟可由寄存器 TADC[2:0] 设置为系统时钟 2 分频, 4 分频, 6 分频, 8 分频, 12 分频, 16 分频, 24 分频, 32 分频。不论寻用多少频率的系统时钟, 都需要保证 ADC 时钟周期大于或等于 $1\mu\text{s}$ 。否则会影响精度。如果实际使用中只需要 8BIT 精度, ADC 时钟周期可以更短一些。
- 3.7.2** 完成一次 A/D 转换需要的时间分 2 部分。首先是采样时间, 可由寄存器 TS[3:0] 设置, 最低 2 个 ADC 时钟周期。然后是转换时间, 固定为 12 个 ADC CLOCK, 因此完成一次 A/D 转换最少 $14\mu\text{s}$ 。外部仿真输入信号必须保证在采样期间固定, 而在转换期间输入信号发生变化不会影响到最终 A/D 转换结果。
- 3.7.3** ADC 内部集成了数字比较器功能, 可以将数字比较器参考值写入数值寄存器, 将此功能打开 (ADCON=101X XXX1B), ADC 一直处在转换状态, 但每次转换完后不会产生中断标志。如果发现转换结果比参考值大, 则会产生中断标志。因为占用了内部 AD 资源, 因此 ADC 功能和数字比较器功能无法同时使用。

3.8 振荡器

- 3.8.1** 25°C 下内部 RC 振荡器频率为 $16.6\text{MHz}\pm 1\%$ 。如果温度变化, 频率会飘移 (温度提高, RC 频率会降低), $-40^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$ 漂移 $16.6\text{MHz}\pm 2\%$ 。

注意: 上面说的频率是取 1024 个时钟周期取平均值。

3.9 看门狗

- 3.9.1** 内置有看门狗电路, 溢出时间从 1ms 到 4s 可调整, 如果在设定时间内没有操作看门狗寄存器 (读或写), 看门狗电路会产生复位信号, 同时将标志位置 1。
- 3.9.2** 看门狗电路拥有单独的内部 RC 振荡器, 但频率不精确, SPEC 上定义的是各种最坏情况下的最短溢出时间。
- 3.9.3** 看门狗电路耗电约 $1\mu\text{A}$, 它可以在代码选项里选择关闭或打开 (在 power down 下有效或无效)。



3.10 UART

3.10.1 TXD/RXD 引脚都和其它功能复用。如果 REN 控制位设为 1，则 RXD 引脚自动设为输入，内部自动拉高。而 TXD 引脚只有在 UART 发送即软件向 SBUF 寄存器写入数据时才会作为 TXD 引脚使用，发送完成后又恢复为 I/O 功能。为了避免接收端误判，在 UART 发送初始化程序中，应该将相应 I/O 状态设为输出高电平。

3.10.2 UART 波特率发生器可以采用 Timer1 或系统时钟，UART 接收数据的波特率最大允许偏差为： $\pm 4\%$ 。

3.11 电流采样模块

3.11.1 电流采样模块集成比较器放大器，比较器集成数字滤波功能，比较器输出可直接关闭 PWM，放大器输出可直接作为 ADC 输入。

3.12 可读识别码

3.12.1 在 SH79F082 每颗芯片中都有一个 8 位的可读识别码，值为 0-255 的随机值，是无法擦除的。它可以由程序或编程工具读出，此功能可以供软件加密使用。

3.12.2 读识别码时，首先，设置 FAC 位为 1，然后给 DPTR 赋值“007FH”，将 A 清 0，再使用“MOVC A, @A+DPTR”来读取。

3.12.3 读完随即码后必须把 FAC 位清 0。

3.13 IO 口

3.13.1 在 spec 中没有用到的端口,应该设为输入上拉,否则可能会导致芯片内部漏电.漏电电流大概在几微安到几百微安范围内.

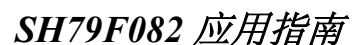


Figure 1 is a detailed schematic diagram of the SH7908M microcontroller system. It includes the following components and connections:

- 12V Power Input:** A 12V DC input connected to a 100nF/25V capacitor (C1) and a 10k resistor (R1). The input is regulated by a 7805 voltage regulator (U1) to provide a 5V supply (VDD) to the microcontroller.
- Voltage Input:** A 5V input connected to a 10k resistor (R2) and a 100nF/25V capacitor (C2). The input is regulated by a 7805 voltage regulator (U2) to provide a 5V supply (VDD) to the microcontroller.
- Reset Circuit:** A reset button (K1) connected to the RESET pin (P15) of the microcontroller. The button is pulled up to VDD by a 10k resistor (R3).
- MCU Bypass Circuit:** A crystal oscillator (XTAL1, XTAL2) connected to the XTAL1 and XTAL2 pins (P10, P11) of the microcontroller. The crystal is a 12MHz crystal (Y1) with 12pF capacitors (C3, C4) connected to ground.
- Microcontroller Pinout:** The SH7908M microcontroller has 24 pins. The pinout is as follows:

Pin	Function	Pin	Function
P10	OPNP1.0	P18	OPNP1.8
P11	OPNP1.1	P19	OPNP1.9
P12	OPNP1.2	P20	OPNP1.10
P13	OPNP1.3	P21	OPNP1.11
P14	OPNP1.4	P22	OPNP1.12
P15	RESET	P23	OPNP1.13
P16	OPNP1.5	P24	OPNP1.14
P17	OPNP1.6		
P18	OPNP1.7		
P19	OPNP1.8		
P20	OPNP1.9		
P21	OPNP1.10		
P22	OPNP1.11		
P23	OPNP1.12		
P24	OPNP1.13		

3.15.1 JTAG 接口 (P1.2-P1.5) 负载电容不能超过 103。特别是 TCK 和 reset pin 复用, 其上电容不能超过 103。



4 应用指南版本历史

版本号	版本记录	时间
1.0	初始版本	2009.05